

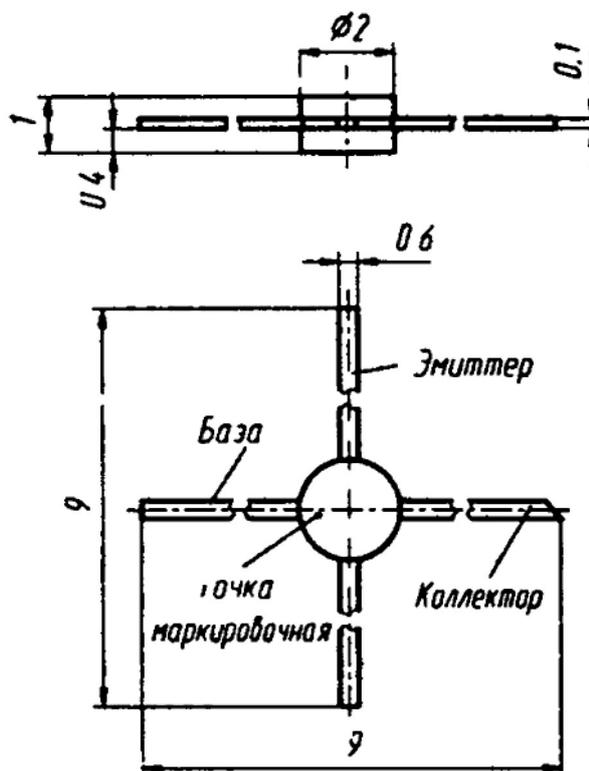
2Т3124А-2, 2Т3124Б-2, 2Т3124В-2

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* усилительные. Предназначены для применения в малошумящих усилителях сверхвысоких частот в составе гибридных интегральных микросхем, обеспечивающих герметизацию. Бескорпусные с гибкими выводами на кристаллодержателе (подложке). Маркируются цветной точкой: 2Т3124А-2 — красной; 2Т3124Б-2 — желтой; 2Т3124В-2 — черной. Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,02 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.

2Т3124(А-2 - В 2i



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 7$ В, $I_3 = 5$ мА	15...100*... 200*
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $I_3 = 5$ мА, $U_{КБ} = 7$ В	6*...7,5*... 8* ГГц
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $I_3 = 5$ мА, $U_{КБ} = 7$ В...	1,8*...2*... 2,5* пс
Минимальный коэффициент шума при $U_{КБ} = 7$ В, $I_3 = 5$ мА:	
$f = 6$ ГГц для 2Т3124А-2	3,9*...4,3*... 5 дБ
$f = 5$ ГГц для 2Т3124Б-2	4,1*...4,5*... 5 дБ
$f = 4$ ГГц для 2Т3124В-2	3,1*...3,3*... 3,6 дБ

Коэффициент усиления по мощности	
при $U_{КБ} = 7$ В, $I_3 = 5$ мА:	
$f = 6$ ГГц для 2Т3124А-2	4...5,3*...6* дБ
$f = 5$ ГГц для 2Т3124Б-2	5...6,7*...8* дБ
$f = 4$ ГГц для 2Т3124В-2	6...6,9*... 7,4* дБ
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 10$ В:	
$T = +25$ °С	0,001*...0,01* ...0,5 мкА
$T = -60$ °С, не более	0,5 мкА
$T = +125$ °С, не более	10 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 1$ В	
	0,001*...0,01* ...20 мкА
Входное сопротивление в режиме малого сигнала в схеме ОБ при $I_3 = 5$ мА, $U_{КБ} = 7$ В, типовое значение	
	6* Ом
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 0$.	
	0,42...0,45*... 0,5* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0$	
	0,52...0,57*... 0,69* пФ

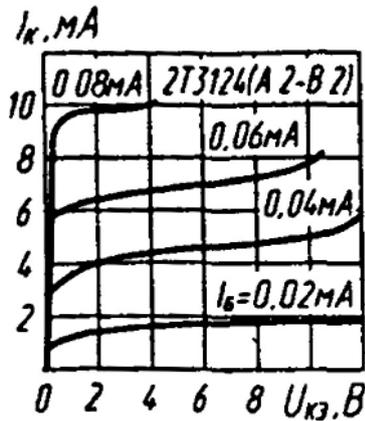
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база	10 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	1 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{БЭ} \leq 1$ кОм	10 В
Постоянный ток коллектора	7 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора' при $T = -60...+85$ °С	70 мВт
Температура окружающей среды	-60...+125 °С

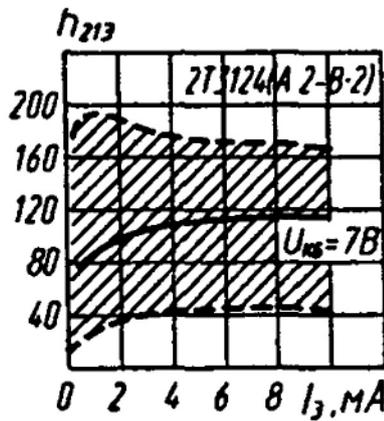
В диапазоне температур +85...+125 °С мощность снижается линейно до 35 мВт.

Минимальное расстояние от кристаллодержателя до места пайки вывода 2 мм, время пайки не более 3 с, температура пайки не более +260 °С.

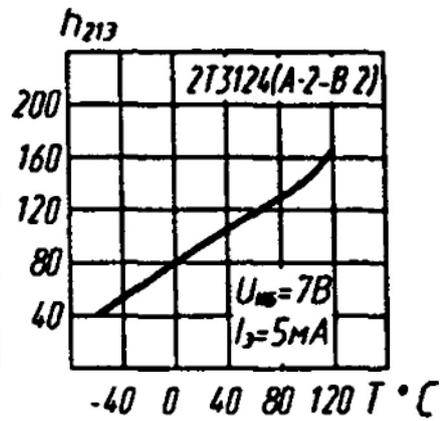
Частотный диапазон применения 2...7,2 ГГц.



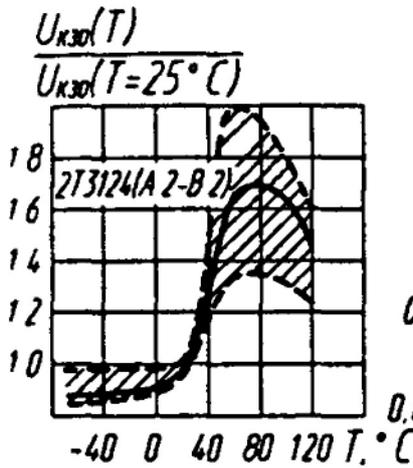
Выходные характеристики



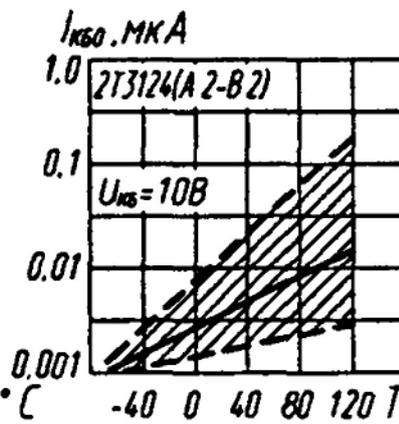
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



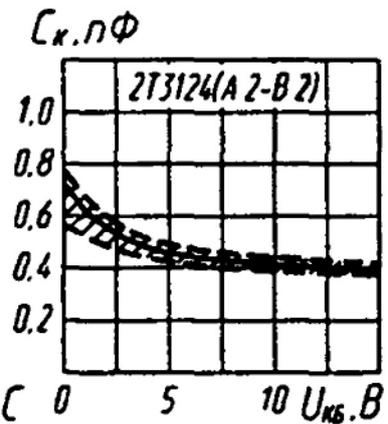
Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры



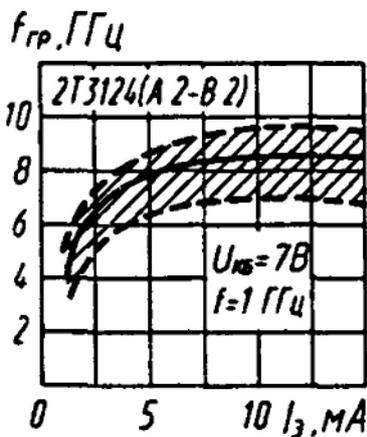
Зона возможных положений зависимости постоянного напряжения коллектор—эмиттер от температуры



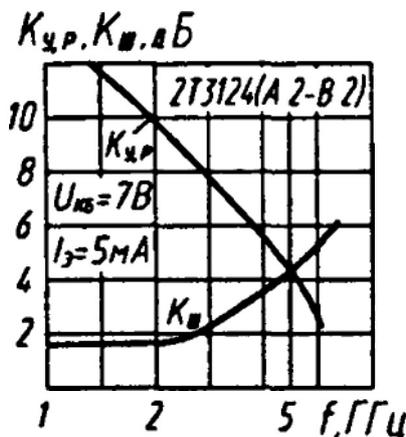
Зона возможных положений зависимости обратного тока коллектора от температуры



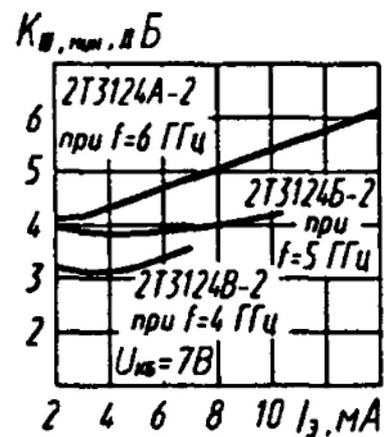
Зона возможных положений зависимости емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор—база



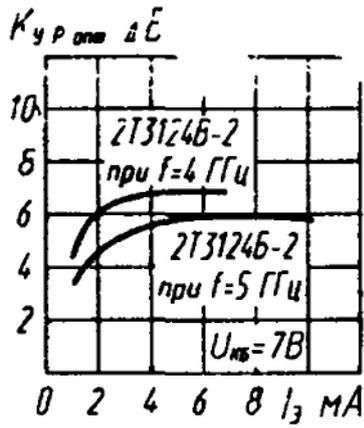
Зона возможных положений зависимости граничной частоты от тока эмиттера



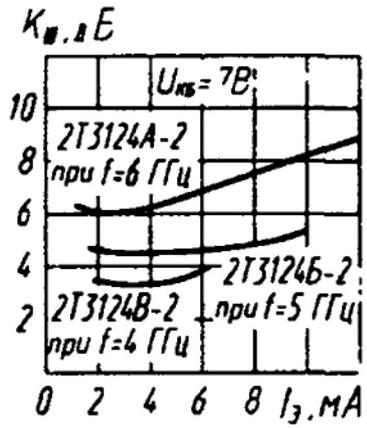
Зависимости коэффициентов шума и усиления от частоты



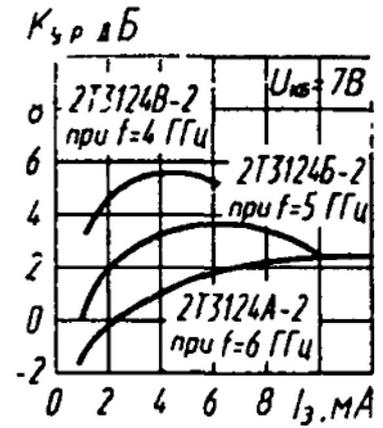
Зависимости коэффициента шума от тока эмиттера



Зависимости коэффициента усиления от тока эмиттера



Зависимости коэффициента шума от тока эмиттера



Зависимости коэффициента усиления от тока эмиттера